




Фотоэлектрические датчики

Сверхтонкий . Сверхкомпактный . Компактный, фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания с встроенным усилителем / Компактный – Тонкий – Фотоэлектрический датчик общего назначения с встроенным усилителем / Цилиндрической формы • Фотоэлектрический датчик цилиндрической формы с большим расстоянием срабатывания с простым монтажом «одним нажатием» /

Серия	Метод определения целевого объекта	Расстояние срабатывания	Целевой объект	Источник света	Время отклика	Источник питания	Потребляемый ток и потребляемая мощность	Регулировка чувствительности	Режим работы	
Миниатюрные фотоэлектрические датчики Серия BS5 <С кабелем>  ① Тип T:(Ш)25×(В)13.5×(Д)22.2 мм ② Тип L:(Ш)26.5×(В)15.4×(Д)16.3 мм ③ Тип K:(Ш)25×(В)6.6×(Д)27.6 мм ④ Тип V:(Ш)13.5×(В)13×(Д)27.6 мм ⑤ Тип Y:(Ш)13.5×(В)15.4×(Д)20 мм	На просвет (без модуляции)	Фиксир. 5 мм	Непрозрачный, мин Ø0.8×2 мм	Инфр. СИД (940нм)	На свет : макс. 20мкс, На затемнение : макс. 100мкс	5-24 В=	Макс. 30 мА	—	На свет/ На затемнение (устанав. с помощью контр. провода)	
	На просвет (без модуляции)	Фиксир. 5 мм	Непрозрачный, мин Ø0.8×2 мм	Инфр. СИД (940нм)	На свет : макс. 20мкс, На затемнение : макс. 100мкс	5-24 В=	Макс. 30 мА	—	На свет/ На затемнение (устанав. с помощью контр. провода)	
	<С разъемом>  ① Тип T:(Ш)25×(В)13.5×(Д)22.2 мм ② Тип L:(Ш)26.6×(В)15.4×(Д)13.3 мм ③ Тип K:(Ш)25×(В)6.6×(Д)27.6 мм ④ Тип V:(Ш)13.5×(В)13×(Д)27.6 мм ⑤ Тип Y:(Ш)13.5×(В)15.4×(Д)20 мм	На просвет (без модуляции)	Фиксир. 5 мм	Непрозрачный, мин Ø0.8×2 мм	Инфр. СИД (940нм)	На свет : макс. 20мкс, На затемнение : макс. 100мкс	5-24 В=	Макс. 30 мА	—	На свет/ На затемнение (устанавливается через клеммный блок)
		На просвет (без модуляции)	Фиксир. 5 мм	Непрозрачный, мин Ø0.8×2 мм	Инфр. СИД (940нм)	На свет : макс. 20мкс, На затемнение : макс. 100мкс	5-24 В=	Макс. 30 мА	—	На свет/ На затемнение (устанавливается через клеммный блок)
* Продаются отдельно для датчиков с разъемом: разъем (СТ-01), кабель разъема (СТ-02, 1 м)										
Диффузионный фотоэлектрический датчик с большим расстоянием срабатывания Серия ВА  (Ш)19×(В)15.5×(Д)48.5 мм	Диффузионный	2 м	Полупрозрачный, непрозрачный	Инфр. СИД (850 нм)	Макс. 1 мс	12-24 В=	Макс. 15 мА	Встроенный регулир. винт	На свет На затемнение На свет На затемнение	

Выход управления	Таймер	Подключение	Условия окружающей среды		Степень защиты	Сертификация	Модель
			Внешняя засветка	Темп. окр. среды			
NPN с открытым коллектором	—	С кабелем (Ø3, 1 м)	Люминесцентная лампа : макс. 1,000 лк (засветка приемника)	-20...55 °C	IP50	CE EAC	BS5-K1M
							BS5-T1M
							BS5-L1M
							BS5-Y1M
							BS5-V1M
PNP с открытым коллектором	—	С кабелем (Ø3, 1 м)	Люминесцентная лампа : макс. 1,000 лк (засветка приемника)	-20...55 °C	IP50	CE EAC	BS5-K1M-P
							BS5-T1M-P
							BS5-L1M-P
							BS5-Y1M-P
							BS5-V1M-P
NPN с открытым коллектором	—	С разъемом	Люминесцентная лампа : макс. 1,000 лк (засветка приемника)	-20...55 °C	IP50	CE EAC	BS5-K2M
							BS5-T2M
							BS5-L2M
							BS5-Y2M
							BS5-V2M
PNP с открытым коллектором	—	С разъемом	Люминесцентная лампа : макс. 1,000 лк (засветка приемника)	-20...55 °C	IP50	CE EAC	BS5-K2M-P
							BS5-T2M-P
							BS5-L2M-P
							BS5-Y2M-P
							BS5-V2M-P
NPN с открытым коллектором	—	С кабелем (Ø3, 2 м)	Дневной свет : макс. 11,000 лк, Лампа накаливания : макс. 3,000 лк (засветка приемника)	-25...55 °C	IP64	CE EAC	BA2M-DDT
							BA2M-DDTD
PNP с открытым коллектором	—	С кабелем (Ø3, 2 м)	Дневной свет : макс. 11,000 лк, Лампа накаливания : макс. 3,000 лк (засветка приемника)	-25...55 °C	IP64	CE EAC	BA2M-DDT-P
							BA2M-DDTD-P